COMMISSIONING AND PERFORMANCE OF INSTRUMENTS FOR XFEL/SPring-8 ACCELERATOR "SACLA"

Yuji Otake^{#A)} on behalf of members of RIKEN XFEL division A) RIKEN, Spring-8 center, XFEL division 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5148, Japan

Abstract

The method of velocity bunching along an injector and magnetic bunching by bunch compressors (BC) with a 3000-times bunch compression factor is employed to make an electron beam of a 3 kA peak with a 30 fs pulse width for the XFEL/SPring-8 "SACLA". Rf phase and amplitude changes of cavities to obtain energy chirp along the bunch for the BCs reflect on the peak current change, which sensitively affects lasing. Therefore, the rf phase and amplitude fluctuation of the cavities must be low to satisfy a demanded electron beam energy variation of 10^{-4} . We have developed very stable instruments for driving the cavities to ensure the stable peak current. During the construction of SACLA, accelerator elements, such as a klystron high-voltage inverter power supply with a 10 ppm (rms) variation at a 45 kV PFN charging voltage and an ultra low-noise master oscillator with an SSB noise of -140 dBc/Hz at 5712 MHz + 1MHz, have been developed and installed. To reduce temperature variation of air surrounding LLRF instruments, which directly conducts to rf phase and amplitude drifts, a 19" rack and an optical fiber duct with a water cooled temperature stabilization function within 0.1 K were developed. Furthermore a precise temperature control system to ensure the phase stability of a cavity was also developed to maintain its temperature within +/- 0.04 K. By this instruments performance, we finally obtained an electron beam energy drift of 1 x 10^{-4} (P-P), a beam arrival time jitter of 22.7 fs (rms).

XFEL/SPring-8 "SACLA"の加速器構成機器の試運転と性能

1. はじめに

X 線自由電子レーザーである XFEL/SPring-8 "SACLA" は 5 年間の建設期間が過ぎ、0.12nm の レーザー発振に成功した^[1]。SACLA の加速器は、 安定なレーザー発振を維持するための高安定な機 器で構成されている。この機器は、電子ビームと レーザーを約 70m のアンジュレータ区間において 4 µm 以内の軌道の重なりに保持することや^[2]、入 射部やシケインのバンチ圧縮部での圧縮係数を一 定にして 3kA、30fs の単バンチビームの強度を1 σで10%以内^[3,4]に保持するために必要である。 このような安定な電子ビームを加速器で生成する ためには、表 1^[4]に示すように加速空洞の高周波 位相と電力変動が、おのおの、時間に換算した最 も厳しい値で 50fs(rms)や 10⁻⁴(rms)以内でなけれ ばならない^[3,4]。この変動抑制は、SCSS 試験加速 器での建設・運転経験から、大・中電力高周波源 の安定化につきると言える。

この安定化の数秒以下の短期性能を実現するに は、計算や経験から、たとえば以下の性能が加速 器の機器に必要である。クライストロン用イン バータ電源(50kV)では100ppm以下の電圧安定化 が必要で、マスターオシレータ(M-OSC)では-120dBc(1kHz SSB)@5712MHz 以下の片側波帯(SSB) ノイズレベルを達成しなければならない。加えて、 M-OSC の後続の低電力高周波機器でもこの性能を 劣化させないことが必要である。以上のほかに、 表1:加速電圧·位相設計許容值

Cavity	DV/V	Df	Dt
	(%rms)	(deg. ms)	(ps rms)
238 MHz SHB	0.01	0.01	0.12
476 MHz Booster	0.01	0.02	0.12
L-band Cor.	0.03	0.06	0.12
Cavity			
L-band APS	0.01	0.06	0.12
Cavity			
C-band Cor.	0.1	0.06	0.049
Cavity			
S-band Accelerator	0.01	0.1	0.097
24C-band Accel.	0.01	0.2	0.097
(up-stream)			
104 C-band Accel.	0.01	0.5	0.24
(Down-stream)			

低電力高周波機器の位相や電力が、電源の電圧変動により比例して変化することが開発段階で明らかになっていた。そのために高周波機器用電源では、出力電圧も-100dBV@10Hz以下のノイズレベルを目指した。

電子ビームのエネルギーやエミッタンスの数秒以 上の長期安定性は、加速器機器設置環境の温度安 定化に大きく依存する。この長期安定性の確保の ためにSACLAでは、加速空洞の±0.04Kの温度安 定化^[5]や機器収納用ラックの0.1K以下の恒温水冷 化、0.1Kの温度安定度の水冷位相安定化光ファイ バーによる高周波基準信号の伝送などの施策を計 画した。本報告では、これらの機器の性能と試運 転の詳細について述べる。

#otake@spring8.or.jp

2. レーザー発生を不安定にする要因

SACLAにおいてレーザー発振の不安定性は、主に 加速高周波電磁場の変動に起因する。それはA. 電 気的なノイズ、B. 環境温度変化、C. 機械振動な どの原因で引き起こされる。それらを定式化して 表すと、以下になる^[6,7]。マイクロ波の波頭に乗っ て加速される電子が感じるエネルギー変動は、

$$E \propto \sqrt{P_{rf}} \varepsilon M \cos(\delta \theta) \tag{1}$$

$$\frac{\delta E}{E} \approx \frac{1}{2} \frac{\delta P_{rf}}{P_{rf}} + \frac{\delta \varepsilon}{\varepsilon} + \frac{\delta M}{M} - \frac{1}{2} \delta \theta^{2}$$
⁽²⁾

で表される。ここでEは電子が獲得するエネル ギーで P_{rf} はクライストロンの出力電力、 ε は規格 化した加速管のエネルギー利得、MはSLEDの電圧 増倍率、 θ は加速高周波に対する電子の位相であ る。また各々の δ の付いた値は、各変動値である。 式中の各々の項を説明すると以下である。

I. 式 (2) の第1項の(1/2) (dp_k / p_k) は, 主に高電 圧パルスモジュレーターの電圧変動に起因するク ライストロンの出力 P_{rf} の変動で、

$$P_{rf} = \eta I_k V_k = \eta k V_k^{2.5}$$
(3)

で表される^[8]。ここで η はクライストロンの効率で、 I_k はカソード電流、kはパービアンス、 V_k はクラ イストロンの印加電圧である。

II. 式(2)の第2項のδε/εは、加速管への入力 高周波の周波数が変ったり、冷却水の温度変化に 伴う空洞の共振周波数の変化によるエネルギー利 得の変化である。

III. 式 (2) の第3項 $\delta M / M$ は、SLED (SLAC energy doubler)高周波パルス圧縮空洞の温度や調整不良による離調と、加速器の運転周波数の変動によるものである。

IV. 最後の項(1/2)($\delta\theta$)²は、加速器を駆動する基 準高周波信号の SSB ノイズや信号伝送路の温度収 縮による位相変動である。この変動は、たとえば M-OSC やクライストロン駆動用の半導体増幅器に 起因する変動に相当する。SSB ノイズによる高周 波信号の時間ジッタへの寄与 N(t)は、

$$N(t) = \int w(f) N_{\text{SSR}}(f) df \tag{4}$$

のノイズの周波数成分の積分で与えられる^[9]。こ こで N_{SSB}(f) は、5712MHz などの連続加速高周波の ノイズで、w(f) は高周波パルス(たとえば 2µs 幅) 変調によるノイズ積分の重み関数(パルス高周波 の幅に相当する周波数を頂点とした三角形の関数 で近似している。)である。この重み関数を掛け るのは、高周波空洞に入る実効ノイズが連続高周 波信号の SSB ノイズ成分とパルス変調の畳み込み になるからである^[10]。以上の変動要因は、数 Hz より高速なものが電気ノイズや機械・音響振動 によるものと考えられる。また数 Hz より低速



図 1: クライストロンモジュレータ用インバータ 電源の電圧安定度。45 kV で 10 ppm (rms、1300 パ ルスの統計)。



図 2: 精密温調制御装置で制御された 238MHzSHB の位相変動および温度安定度 (24 h)。0.015 度 (STD)の位相変化(赤、上)および±0.04 K以下 の温度変化(青、下)。

なものは、主に環境温度の変化に依存した物と 考えられる。上記の不安定性要因を検討して、 そのレーザーへの影響が要求値以内に納めるよ うに定めた機器の目標性能例が、前節で述べた 値である。

3. 機器の安定化と性能

3.1 クライストロンの高電圧安定化

表1に示すような安定度を達成するためには、 第一には、クライストロンの印加電圧の安定化が 必要不可欠である。それは、クライストロンへの 印加高電圧パルス(4~5 マイクロ秒幅)を形成す るモジュレータ用 PFN(pulse forming network)を 充電するための、インバータ電源の安定度で決ま ると言っても良い。理研の XFEL 部門では、(3)式 から求めた 100 ppm (rms)の目標電圧安定度を達 成するために、PFN 充電用の主充電器と充電完了 後のきめ細かい電圧制御用の補充電器を組み合わ せた、50 kV のインバータ電源を開発した。詳細 については、文献[11]に示す白澤ほかの発表を参 照していただきたいが、図1に示すような1300パ ルの統計で10 ppm (rms)の安定度を達成した。

 3.2 加速空洞・SLED・クライストロンなどの大電 力高周波装置の安定化

SCSS試験加速器における実験結果から、SACLAの 入射部では、238MHzのSHB(sub-harmonic buncher)

空洞でその加速位相の変化が0.05度程度でもレー ザー発振に影響することが明らかとなっていた^[5]。 このことから、既に開発していた加速空洞の温度 を安定化するPLC (program logic controller) 制 御装置^[12]をより高精度化して使用した。この制御 装置は、白金抵抗体で空洞への入力冷却水温度を 測定して、ヒーターへのAC 200 V電力をゼロクロ ス半導体リレーで入り切りするPWM (pulse width modulation)制御により空洞入り口の水温を一定に する方式をとっている。制御方式は、一般的なPID (proportional integral differential)方式を採 用している。空洞の熱容量が大きく本体の熱時間 応答の遅延量が大きいことから、空洞外壁の温度 を測定せず、制御遅延の少ない空洞への入力水温 の制御とした^[5]。このことから、図2に示すような 238MHzのSHBの±0.04 K以下の温度安定度を得てお り、基準高周波信号への帰還制御を行う事で高周 波位相の変化は0.015度(STD)になっている。加 速器の運転周波数の変動による加速空洞および SLED空洞の離調は、後述するマスターオシレータ の11桁の周波数安定度により無視できる。空洞本 体の温度変化による離調は、先に述べた精密温調 装置で0.1度以下に制御されているので、これも問 題ない。たとえば、SLEDの温度離調が97 kHz/Kで あることを考えると当面の加速器運転には対応で き、加速空洞はそれより遥かに低感度である。ち なみに以上の条件下では、精密温調装置の設定温 度を変更することで加速管およびSLED空洞の共振 周波数も変更可能で、最終的にSLED空洞では、70 台近くある全てで共振周波数が5712 MHz±50 kHz 程度に調整されている^[13]。

以上に述べた以外のCバンド大電力クライストロンや高電圧パルスモジュレータ、前節のインバータ電源などの大電力高周波機器でも、自身の温度変化に対する特性のドリフトを持つ。この特性変化の例は、クライストロンの出力位相やインバータ電源の充電電圧のドリフトである。このような機器は消費電力が大きいため、必然的に水による冷却が必要である。そのため、この機器の冷却を0.2 K程度に制御された恒温水で行うことで、温度による特性変化を低減している。

3.3 低電力高周波系の安定化

3.3.1 時間ジッタ(SSBノイズ)の低減

低電力高周波(LLRF)系において、マスターオ シレータ(M-OSC)で発生した加速用高周波のノイ ズが大きいと、ランダムなビームの加速エネル ギー変動や時間ジッタにつながる。特に数Hzより 高速なノイズ成分は、60 ppsなどの繰り返し動作 をするSACLAのリニアックでは、サンプリング定理 から制御不能な致命的なものになる。加えて半導 体や同軸ケーブルでは、環境温度や機械振動の影



図 3: M-OSC の SSB ノイズ(5712 MHz,茶,下)、 400 m 光伝送後のノイズ(黒,中)の増加、伝送後に 接続されている IQ 変調器の出力ノイズ(水色、 上)。ピークは測定のノイズである。

響を直接受けて高周波電力・位相が変動するので、 それにより同様の不安定性を加速電子ビームに与 える。よってこれらの影響を軽減することは、安 定なレーザー発振には必要不可欠である。以上の 理由から、我々は非常に低ノイズなM-OSCを開発し た^[14]。図3にはその5712 MHz出力高周波のSSBノイ ズスペクトラムを示す。ノイズレベルは、5712 MHzから測って1MHz付近で-140 dBc/Hzに達してい る。加速高周波の位相変動は、10 Hz以下の低速な ものはフィードバックで低減されると考え、2節で 述べた連続高周波に対するクライストン用のパル ス変調の効果を考えた三角形の重み関数を用いて (パルス幅の周波数が頂点で、それは2µsパルス幅 で0.5 MHzである。)、図のノイズスペクトラムを 周波数軸上で積分して得られる^[15]。その場合、 SSBノイズを10 Hzから10 MHzまで積分して得られ る時間ジッタは30 fs 程度であり、我々の要求に 十分に答えられる性能である。このように信号源 で十分な低ノイズを実現したとしても、それに接 続される光ファイバー基準高周波伝送路や高周波 の位相・電力制御機器がノイズを増やしたのでは 意味がない。そのためにLLRF機器の全系に渡って、 M-OSCのノイズを増加させない機器を開発した。図 3には、M-OSCで発生した5712 MHzの高周波を400 m の位相安定化型シングルモード光ファイバー使っ て伝送後の、SSBノイズスペクトラムを示す。ちな みにこのデータは、SACLAのクライストロンギャラ リーにて取得されたものである。図から判ること は、信号の400 mの伝送後においても1 MHz以上の 周波数帯で7 fs程度しかノイズを増やしていない ことである。加えて、この光ファイバーラインの 後続に接続された高周波電力・位相制御機器やク ライストロン駆動パルス増幅器でも、M-OSCのノイ ズレベルを僅かに増加させるのみの特性となって いる。図3には、例として5712 MHzのIQ変調器の出 カノイズスペクトルも載せる。この低ノイズ実現 の一つの大きな立役者は、高周波・光信号伝送・ 制御機器用電源の低ノイズ化にある。図4には、開

発したLLRF機器用電源のノイズスペクトラムを載 せる。ノイズレベルは、アナログ用の24 V DCの 10Hzにおいて-150dBVに達成しており、長期の電圧 安定度も10 ppmを下回ったものとなっている。以 上以外の加速高周波の時間ジッタの要因としては、 同軸や光ファイバーケーブルなどの高周波・光信 号伝送部品に対する機械・音響振動がある。これ は10 Hzから2 KHzの周波数帯で、振動する部分に 音や冷却用の風が当ら無いようにウレタンや金属 箱などで囲うことで、熱絶縁をかねて防振につと めた。また大きな部品や15Dなどの太い同軸ケーブ ルは、固定を強化する事で振動しないようにした。



図4:LLRF・ビームモニター用低ノイズ電源のア ナログ用24V-DCのノイズスペクトラム。ノイズ レベルは10Hzで-150dBV以下である。

3.3.2 高周波電力・位相ドリフトの低減

LLRF系で加速高周波の電力・位相ドリフトを低 減するためには、環境温度の変化を少なくする事 が非常に効果的である。加えて、このような温度 変化の低減後に、それでも残った電力・位相ドリ フトを帰還制御で少なくすることが、制御のダイ ナミックレンジを狭めて制御性を良くするために 意味がある。以上の理由から、我々は、LLRF機器 を収納する19インチラックに恒温水による温度安 定化を行う機能を開発し付加した。このラックは 恒温水でラック内部を循環する空気を熱交換する 構造である。また、ラック収納機器の表面の高周 波同軸ケーブルを振動させないように、機器の側 面から空気を導入して冷却の必要な部分のみを冷 やし、機器背面から排気して熱交換器を通り再度 機器に戻される構造とした。このラックの温度安 定度を図5に示す。このラックにより、内部は0.1 K以下の温度安定度を達成している。ちなみに冷却 水の温度変化も同程度である。このラック内の温 度変化は、ほぼ冷却水およびクライストロンギャ ラリーの温度変化に比例しているが、ラックの設 置場所であるクライストロンギャラリーの温度変 化は1 K程度である。SACLAが約1 kmの長さを持つ ので、電気的な基準高周波伝送の減衰を除くため に光ファイバーの基準高周波伝送路を使用してい る。このため、目標の位相安定度を実現するため には、この場合も環境温度の変化が大きな障害と



図5:水冷恒温19"ラックの温度安定性、上から M-OSC 収納ラックおよび入射部のLLRF 機器用 ラックの温度である(緑、黒)。3番目(赤)は 恒温冷却水の戻りの温度。一番下(青)は恒温冷 却水の温度である。



図 6:水冷恒温光ファイバーダクトの温度安定性 (0.1 K 以下の変動)と、ファイバーによる 5712 MHz 基準高周波信号の 200 m 光伝送による位相変 動(1.5 度、P-P、グラフの一番下、赤)。グラフの 上の2つがダクト内の温度変化(黒、茶色)で、3 番目(水色)がクライストロンギャラリーの温度 変化である。

なる。この影響を軽減するために、我々は温度の 変化に対する光路長の変化の係数が2 ppm/Kの位相 安定化型光ファイバー^[16]を使用した。加えて、先 のラックと同様にこのファイバーを外と内の2重金 属壁構造の水冷恒温ダクトに納めた^[17]。ファイ バーは、内ダクト内に断熱材を巻き収納され、内 ダクトと外ダクトの間および内ダクト内も断熱材 を充填して熱絶縁を良くし、これが防振の役割も 担っている。冷却は、内ダクト金属表面のみを恒 温冷却水で冷やしている。このような構造により ダクト外部の温度変化は、内ダクト内部で1/5の 0.15度程度に低減される。そのダクト内外の温度 変化の様子を図6に示す。同じく図6には、クライ ストロンギャラリー内において、5712 MHzの光高 周波信号を恒温ダクトに納められた光ファイバー により200 mに渡って伝送した場合の位相ドリフト の測定結果を示す。位相変動は、0.15 K程度のダ クト内の温度変化に対応して1.5 度になっている。 これは、ファイバーの2 ppm/Kの光路長温度係数か ら計算した値と調和的である。



図 7:加速器終点部での 7 GeV 加速電子ビームの エネルギー安定性。パルス毎で 1.4 x 10⁻⁴ (rms)、グ ラフ上の 100 ショット平均のエネルギードリフト が 1.0 x 10⁻⁴ (p-p) である。



図 8:加速器のバンチコンプレッサー下流の 1,45 GeV の場所に設置された、RF デフレクターで測定 されたビームジッタ。1pps の繰り返しで 100 ショットのデータ。22.7 fs (STD)のジッタである。

4. 加速電子ビームの安定性

今まで述べてきた安定化の施策と、これによっ て得られた安定化した基準高周波信号により加速 空洞内の高周波電力・位相帰還制御、電子ビーム のエネルギー安定化帰還制御、入射部の速度変調 終端部における電子ビームの到達時間帰還制御を 行っている。これにより図7の加速電子ビームのエ ネルギー安定度や図8の時間ジッタを得ている。こ の図から、7 GeVの加速器終端部での電子ビームの エネルギードリフトは6時間1.0 x 10⁻⁴ (p-p)で、 パルス毎のエネルギージッタが1.4 x 10⁻⁴ (rms) である。加えて、1.45 GeVでのRFデフレクタによ るバンチ構造測定で電子ビームの時間ジッタは、 22.7 fs (rms) ある。

5. まとめ

SACLAにおいて、今まで述べてきたような空洞で の電子の加速電圧・位相の安定化施策を行った。 その施策により、我々はクライストロンの高電圧 で10 ppm (rms)におよぶ電圧安定度を達成し、基 準高周波発生用信号源においては1 MHz付近のSSB で-140 dBc/Hzの低ノイズレベルを実現した。また、 精密温調装置により238MHzSHB空洞の±0.04 K以 下の温度安定化を達成し、0.015度 (STD)の位相 安定性も得た。この結果として、電子ビームにお いて1.0 x 10⁻⁴ (p-p)の加速エネルギーのドリフ トや22.7 fs (rms)の時間ジッタが得られ、安定 なX線のレージングに不可欠な機器の性能を満足した。

参考文献

- [1] 田中 均、動き始めた X 線自由電子レーザー施設 SACLA の運転状況、本学会報告集 (2011)。
- [2] T. Tanaka *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A 528, 172 (2004).
- [3] 田中 均ほか、XFEL/SPring-8 のビームパラメー ターの基本特性、第 4 回加速器学会報告集、610-612 (2007)。
- [4] 田中 均ほか、XFEL/SPring-8 のバンチ圧縮性能に 及ぼす RF 機器変動の影響評価、第4回加速器学会 報告集、613-615 (2007)。
- [5] 前坂比呂数ほか、SCSS の試験加速器の RF システムの高精度化、第 5 回加速器学会報告集、530-532 (2008)。
- [6] P. M. Lapostolle and A. L. Septier (Eds), *Linear Accelerators*, North-Holland, 322-329 (1970).
- [7] I. Sato et al. (Eds), Design on PF Injector Linac Upgrade for KEKB, KEK Report 95-18, 188 (1996).
- [8] J. S. Oh, Stable RF Phase Insensitive to the Modulator Voltage Fluctuation of the C-Band Main Linac for SCSS XFEL, proc. of FEL06, 684-687 (2006).
- [9] S. Goldman, Frequency Analysis, Modulation and Noise, DOVER, 211-215 (1967).
- [10] 越川常治、信号解析入門、近代科学社、25-26、 69-70 (2001)。
- [11] 白澤克年ほか、SACLA 主加速器の運転状況、本学 会報告集 (2011)。
- [12] S. Takahashi et al., Precise Temperature Regulation System for C -band Accelerating Structure, proc. of APAC04, 678-680 (2004).
- [13] 稲垣隆宏ほか、C バンド加速器における RF パルス 圧縮器の調整、本学会報告集 (2011)。
- [14] Y. Otake et al., Timing and LLRF System of Japanese XFEL to Realize Femto -second Stability, Proc. of ICALEPCS07, 706-710 (2007).
- [15] Y. Otake et al., SUB -PICOSECOND TRIGGER SYSTEM FOR THE SCSS PROTOTYPE ACCELERATOR, Proc. of FELO6, 645-648 (2006).
- [16] S. Tanaka, Phase Stabilized Optical Fiber, Tec. Rep. of Sumitomo Electric Ind. Ltd., (1989).
- [17] H. Hosoda et al. CONSTRUCTION OF AN TIMING AND LOW -LEVEL RF SYSTEM FOR XFEL/SPRING -8, Proc. of IPAC10, 2191-2193 (2010).